

DIALOG(R) File 351:DERWENT WPI
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

010485904 **Image available**

WPI Acc No: 1995-387250/199550

XRAM Acc No: C95-166712

XRPX Acc No: N95-282990

Plasma treatment device for semiconductor material etc. - has microwave generator and dielectric material in waveguide.

Patent Assignee: HITACHI LTD (HITA)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 7263186	A	19951013	JP 9446821	A	19940317	199550 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9446821 A 19940317

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

JP 7263186	A	6	H05H-001/46
------------	---	---	-------------

Abstract (Basic): JP 7263186 A

The device has a dielectric of which the specific conductivity is greater than 1 at all part or a part of a section which is perpendicular to a microwave transmittance direction in a wave guide.

USE - Plasma treatment device for a semiconductor board etc. consists of a plasma generator which uses microwave, a decompressible treatment chamber, a gas supplying device and a vacuum exhaust device.

PLASMA TREATMENT DEVICE

Patent Number: JP7263186
Publication date: 1995-10-13
Inventor(s): WATANABE SEIICHI; others: 02
Applicant(s):: HITACHI LTD
Requested Patent: JP7263186
Application Number: JP19940046821 19940317
Priority Number(s):
IPC Classification: H05H1/46 ; C23F4/00 ; H01L21/205 ; H01L21/3065 ; H01L21/31 ; H01P7/06 ; H01Q13/10
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To make a microwave transmission part compact.
CONSTITUTION:In a plasma treatment device utilizing microwaves, a dielectric 9 whose specific dielectric constant ϵ_r is larger than 1 is installed in the whole of a cross section vertical to the microwave transmitted direction within a wave guide 5, or in part of the cross section. Thereby, the wavelength of the microwave within the dielectric becomes $1/\sqrt{\epsilon_r}$ times the wave length of microwaves in the air.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

特開平7-263186

(43)公開日 平成7年(1995)10月13日

(51)Int.Cl.⁶

H 05 H 1/46

C 23 F 4/00

H 01 L 21/205

識別記号 庁内整理番号

C 9014-2G

D 8417-4K

F I

技術表示箇所

H 01 L 21/ 302

21/ 31

B

C

審査請求 未請求 請求項の数9 O L (全 6 頁) 最終頁に統く

(21)出願番号

特願平6-46821

(22)出願日

平成6年(1994)3月17日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 渡辺 成一

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

(72)発明者 古瀬 宗雄

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

(72)発明者 白米 茂

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

(74)代理人 弁理士 小川 勝男

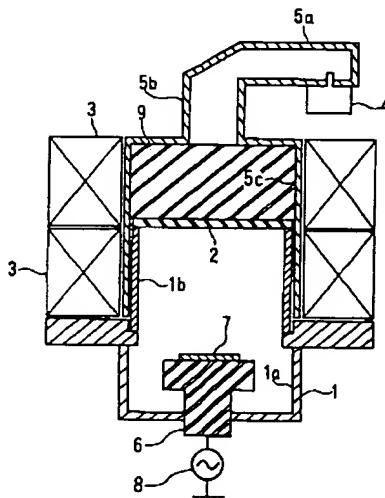
(54)【発明の名称】 プラズマ処理装置

(57)【要約】

【構成】マイクロ波を利用したプラズマ処理装置において、導波管5内のマイクロ波が伝送される方向と垂直な断面全部あるいは該断面の一部に、比誘電率 ϵ_r が1より大きい誘電体9を設けるよう構成した。

【効果】誘電体内でのマイクロ波の波長は空気中のマイクロ波の波長の $1/\sqrt{\epsilon_r}$ 倍となるので、マイクロ波の伝送部を小型化することが可能になった。

図1



1 … 处理室

1a … 容器

2 … 石英窓

5a, 5b, 5c … 導波管

6 … 試料台

9 … 誘電体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】マイクロ波を利用したプラズマ発生装置と減圧可能な処理室とガス供給装置と真空排気装置より成るプラズマ処理装置において、導波管内のマイクロ波が伝送される方向と垂直な断面全部あるいは該断面の一部に、比誘電率が 1 より大きい誘電体を設けたことを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項 2】請求項 1 記載のプラズマ処理装置において、誘電体が液体あるいは流動性の固体であるプラズマ処理装置。

【請求項 3】請求項 1 記載のプラズマ処理装置において、マイクロ波を利用したプラズマ発生装置におけるマイクロ波の周波数を 0.2 ~ 1.2 GHz としたプラズマ処理装置。

【請求項 4】マイクロ波を利用したプラズマ発生装置と減圧可能な処理室とガス供給装置と真空排気装置より成るプラズマ処理装置において、プラズマ発生に使用する周波数のマイクロ波を伝送できない大きさの空洞の導波管内に比誘電率が 1 より大きい誘電体を設け、導波管内をマイクロ波が伝送できるようにしたことを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項 5】請求項 4 記載のプラズマ処理装置において、誘電体が液体あるいは流動性の固体であるプラズマ処理装置。

【請求項 6】請求項 4 記載のプラズマ処理装置において、マイクロ波を利用したプラズマ発生装置におけるマイクロ波の周波数を 0.2 ~ 1.2 GHz としたプラズマ処理装置。

【請求項 7】周波数 0.2 ~ 1.2 GHz のマイクロ波を利用したプラズマ発生装置と減圧可能な処理室とガス供給装置と真空排気装置より成るプラズマ処理装置において、マイクロ波空洞共振器の壁面の一部にスロットアンテナが設けられ、該スロットアンテナより放射されるマイクロ波によりプラズマが生成されることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項 8】周波数 0.2 ~ 1.2 GHz のマイクロ波を利用したプラズマ発生装置と減圧可能な処理室とガス供給装置と真空排気装置より成るプラズマ処理装置において、TE₀₁ モードのマイクロ波を処理室内に導入し、プラズマを生成することを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項 9】周波数 0.2 ~ 1.2 GHz のマイクロ波を利用したプラズマ発生装置と減圧可能な処理室とガス供給装置と真空排気装置より成るプラズマ処理装置において、処理室に接続された導波管または共振器と整合器との間を同軸構造で接続すること、あるいは該整合器とマイクロ波を発生させる電源との間を同軸構造で接続することを特徴とするプラズマ処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明はプラズマ処理装置に係り、特に半導体素子基板等の試料をプラズマを利用してエッティング処理及び成膜処理等するのに好適なプラズマ処理装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】工業周波数に指定されているためよく使用される 2.45 GHz の周波数よりも低い周波数のマイクロ波を利用したプラズマ処理装置は、例えば、特開平 3-238800 号公報に記載のように、空洞の導波管によりマイクロ波を処理室内に導入し、プラズマを生成するよう構成されていた。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、導波管内を伝播するマイクロ波の波長の大きさ、及びマイクロ波を伝送する導波管のマイクロ波伝送方向に垂直な断面の大きさの点について配慮がされていなかった。通常使用される 2.45 GHz の周波数よりも低い周波数のマイクロ波を使用した場合、導波管内を伝播するマイクロ波の波長は、2.45 GHz の周波数のマイクロ波の波長よりも長くなる。このため、装置がマイクロ波の伝送方向に大きくなるという問題点があった。また、2.45 GHz の周波数よりも低い周波数のマイクロ波を使用した場合、マイクロ波を伝送する導波管のマイクロ波の伝送方向に垂直な断面の大きさは、2.45 GHz の周波数のマイクロ波を伝送する導波管の場合と比較して、大きくなるという問題点があった。

【0004】本発明は、マイクロ波の伝送部を小型にすることが可能なプラズマ処理装置を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、導波管内のマイクロ波が伝送される方向と垂直な断面全部あるいは該断面の一部に、比誘電率が 1 より大きい誘電体を設けたものである。

【0006】

【作用】導波管内に設けた誘電体の比誘電率を ϵ_r とすると、誘電体内でのマイクロ波の波長は、空気中のマイクロ波の波長の $1/\sqrt{\epsilon_r}$ 倍となる。したがって、 $\epsilon_r > 1$ の誘電体を導波管内に設けることにより、マイクロ波の伝送部を小型化することが可能である。

【0007】

【実施例】以下、本発明の一実施例を図 1 により説明する。図 1 は、本発明の一実施例である有磁場マイクロ波ドライエッティング装置を示す。容器 1a, 放電管 1b 及び石英窓 2 で区画された処理室 1 の内部を真空排気装置(図示省略)により減圧した後、ガス供給装置(図示省略)によりエッティングガスを処理室 1 内に導入し、所望の圧力に調整する。また、処理室 1 はコイル 3 により生成される磁場領域内にある。マグネットロン 4 より発した、例えば、0.915 GHz のマイクロ波は導波管 5

a, 5 b, 5 c 内を伝播し、石英窓 2 を透過して処理室 1 内に入射される。このマイクロ波によって生成されたプラズマにより、試料台 6 に載置された被処理材のウエハ 7 がエッティング処理される。また、ウエハ 7 のエッティング形状を制御するため、試料台 6 には、整合器（図示省略）を介して高周波電源 8 が接続され、高周波電圧が印加される。

【0008】本実施例の場合、導波管 5 c 内に比誘電率 $\epsilon_r = 2.1$ のテフロンを用いた誘電体 9 を設けている。導波管 5 c に誘電体 9 を設けない場合と比較して、誘電体 9 中でのマイクロ波の波長は $1/\sqrt{\epsilon_r} = 0.69$ 倍になる。このため、導波管 5 c 内に誘電体 9 を設けることにより導波管 5 c の大きさ（この場合マイクロ波の進行方向の長さ）を 0.69 倍に短縮できる。テフロン以外にも比誘電率が 1 より大きい誘電体 9、例えば、アルミナセラミックス ($\epsilon_r = 8.5$) や石英 ($\epsilon_r = 3.8$) を用いてもよい。本実施例によれば、導波管内

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{\epsilon\mu}} \left\{ \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b} \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \quad \text{--- 数 1}$$

【0011】ここで、 ϵ は誘電率、 μ は透磁率である。真空中での誘電率を ϵ_0 とすると $\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$ であるので、導波管内に比誘電率 ϵ_r の誘電体を設けると、遮断周波数 f_c は $1/\sqrt{\epsilon_r}$ 倍になる。したがって、誘電体を設けない場合には、遮断周波数より小さい周波数であるため伝送できないマイクロ波でも、誘電体を設けることにより遮断周波数が $1/\sqrt{\epsilon_r}$ 倍となるため、マイクロ波を伝送できる場合があり、すなわち導波管の遮断も誘電体を設けることにより小さくできる。円形導波管等各種導波管でも、矩形導波管と同様に誘電体を設けることにより導波管の断面を小さくすることができる。また、前述の例では、導波管内のマイクロ波が伝送される方向と垂直な断面全部に誘電体を設ける場合について述べたが、該断面の一部のみに誘電体を設けてもよい。さらに、前述の例では固体の誘電体を使用していたが、非極性の液体の誘電体、例えばシリコンオイル ($\epsilon_r = 2.2$) を使用してもよい。3 スタブチューナあるいは EH チューナ等可動部がある部分には、液体の誘電体を使用するのが便利である。

【0012】本発明の第 3 の実施例を図 3 及び図 4 により説明する。周波数 0.2 ~ 1.2 GHz のマイクロ波を使用する場合には、マイクロ波の波長は 2.45 GHz の場合より長くなる（無限空間での波長の場合、0.2 GHz では 2.2 倍、1.2 GHz では 2.04 倍となる。）ので、マイクロ波伝送部の小型化が実用上重要である。また、周波数 0.2 GHz 以下では減衰が大きいためマイクロ波を導波管を用いて伝送することが難しく、実用上、（均一性を得る上で）放電管 1 b の径よりもウエハ 7 の径が小さい方が望ましい。

に比誘電率 ϵ_r が 1 より大きい誘電体を設けたことにより、誘電体内でのマイクロ波の波長が $1/\sqrt{\epsilon_r}$ 倍になるので、それだけマイクロ波の伝送部を小型にすることができるという効果がある。

【0009】本発明の第 2 の実施例を図 2 により説明する。本実施例では、比誘電率 ϵ_r が 1 より大きいテフロンを用いた誘電体 9 を導波管 5 a 及び 5 b 内に設けている。これにより、第 1 の実施例と同様にマイクロ波の伝送部を小型にすることができるという効果がある。また、誘電体 9 を導波管 5 a, 5 b 内に設けることにより導波管の遮断周波数を小さくすることができる。例えば、導波管 5 a, 5 b の断面の各辺の長さが a, b である矩形導波管における TE_{nm} モードのマイクロ波の遮断周波数 f_c は以下のように記述される。

【0010】

【数 1】

$$f_c = \frac{u_{nm} \cdot c}{2\pi a} \quad \text{--- 数 2}$$

【0013】円形導波管の場合、遮断周波数 f_c は、導波管の半径を a、光速を c として、下記のように表される。

【0014】

【数 2】

【0015】ここで、TE₁₁ モードの場合 $u_{nm} = 1.841$ である。ウエハ 7 の直径を 6 インチとし、放電管 1 b の直径が 6 インチ相当以上とすると、円形 TE₁₁ モードしか伝播できないマイクロ波は、周波数が 1.2 GHz 以下である必要がある。したがって、周波数 0.2 ~ 1.2 GHz のマイクロ波を使用することが望ましい。

【0016】本実施例の場合、マグネットロン 4 から発振された、例えば、周波数 0.915 GHz のマイクロ波は、導波管 5 a, 5 b 内を伝播し、共振器 9 に導入される。共振器 9 の底面に図 4 に示すスロットアンテナ 10 が設けられている。スロットアンテナ 10 より放射されたマイクロ波が導波管 5 d 及び石英窓 2 を通過し、処理室 1 内に入射されプラズマが生成される。本実施例の場合、共振器 9 構造を有しているので、マイクロ波の伝送方向に対して装置を小型化できるという効果がある。また、同じく共振器 9 構造でスロットアンテナ 10 によりマイクロ波を放電するため、安定にマイクロ波を供給でき、その結果安定にプラズマを生成できるという効果がある。さらに、共振器 9 を円形 TE₀₁ モード用共振器とし、図 4 に示すように放射状の円形 TE₀₁ モード用スロ

ットアンテナ10を使用し、スロットアンテナ10と石英窓2の間に一定間隔を設けることにより、円形TE₀₁モードのマイクロ波を処理室1に入射できるので、より均一なプラズマを生成することも可能である。

【0017】本発明の第4の実施例を図5により説明する。本実施例では、先の実施例でマイクロ波の伝送方向を変更するため使用していた導波管5のコーナ部をなくし、共振器9と導波管5aとの間に結合窓11を設け、マイクロ波を伝送するようにしたものである。本実施例によれば、導波管5のコーナ部をなくすことができるのでさらに装置の小型化が可能であるという効果がある。

【0018】本発明の第5の実施例を図6により説明する。本実施例では、高周波電源12により生成された高周波電圧を整合器13を介して共振器9に供給している。高周波電源12には0.5GHzの周波数を使用しており、高周波電源12と整合器13及び整合器13と共振器9とは同軸構造14（本実施例の場合同軸ケーブル）により接続されている。また、同軸構造14により伝送された高周波電圧は、アンテナ15により共振器9と結合され、マイクロ波に変換された後、処理室1内に入射される。本実施例では、さらに装置を小型化できるという効果がある。

【0019】本発明の第6の実施例を図7により説明する。本実施例では、マグнетロン4より発したマイクロ波を一度、同軸構造14（本実施例の場合同軸ケーブル）により伝送し、再び共振器9内でアンテナ15によりマイクロ波に変換し、処理室1内に入射している。本実施例においても装置を小型化できるという効果がある。

【0020】また上記各実施例では、有磁場ドライエッジ装置について述べたが、その他のマイクロ波を利用したドライエッチング装置、プラズマCVD装置、アシシング装置等のプラズマ処理装置についても、同様の作用効果が得られる。

【0021】

【発明の効果】本発明によれば、マイクロ波の伝送部を小型にすることが可能なプラズマ処理装置を提供できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の有磁場マイクロ波ドライエッチング装置の処理室部の縦断面図である。

【図2】本発明の第2の実施例の有磁場マイクロ波ドライエッチング装置の処理室部の縦断面図である。

【図3】本発明の第3の実施例の有磁場マイクロ波ドライエッチング装置の処理室部の縦断面図である。

【図4】図3のスロットアンテナを上部より見た図である。

【図5】本発明の第4の実施例の有磁場マイクロ波ドライエッチング装置の処理室部の縦断面図である。

【図6】本発明の第5の実施例の有磁場マイクロ波ドライエッチング装置の処理室部の縦断面図である。

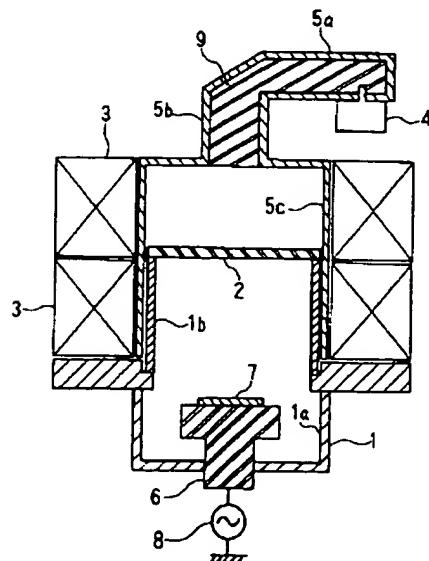
【図7】本発明の第6の実施例の有磁場マイクロ波ドライエッチング装置の処理室部の縦断面図である。

【符号の説明】

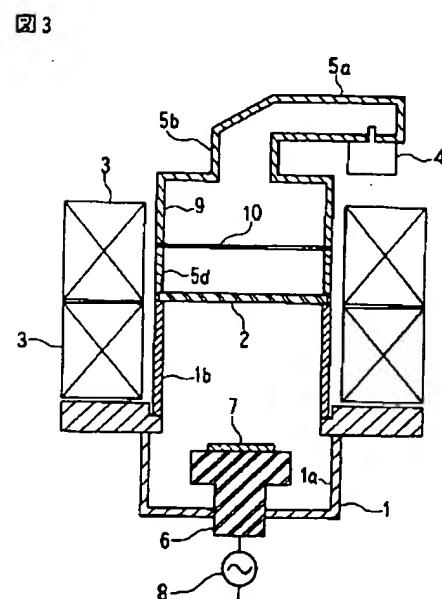
1…処理室、1a…容器、1b…放電管、2…石英窓、3…コイル、4…マグネットロン、5a、5b、5c、5d…導波管、6…試料台、7…ウエハ、8…高周波電源、9…誘電体、10…スロットアンテナ、11…結合窓、12…高周波電源、13…整合器、14…同軸構造、15…アンテナ。

【図2】

図2

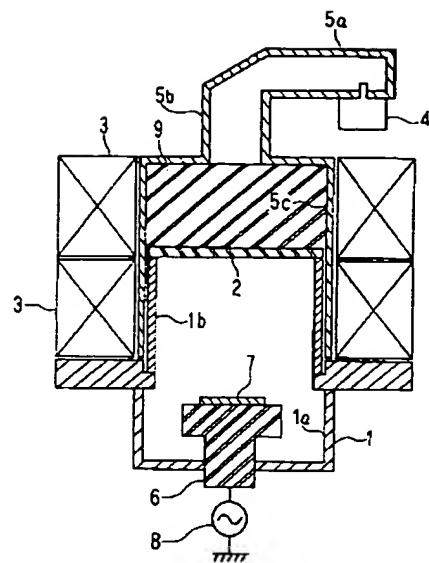


【図3】



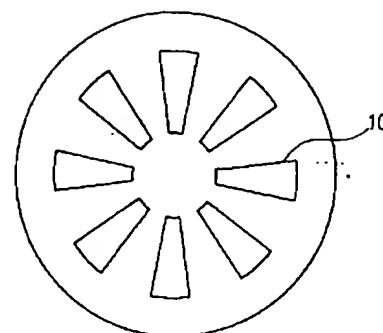
【図1】

図1



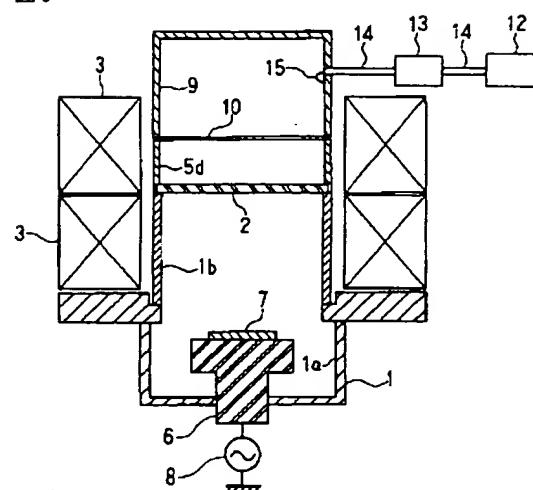
【図4】

図4



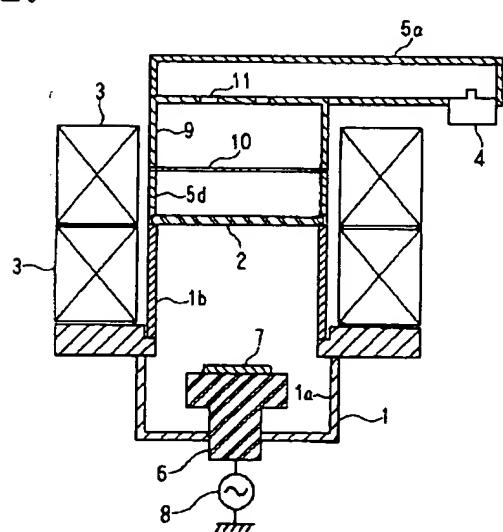
【図6】

図6



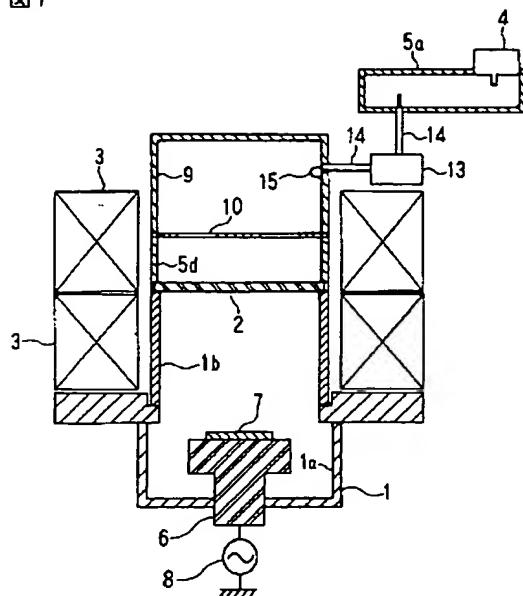
【図5】

図5



【図7】

図7



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

府内整理番号

F I

技術表示箇所

H 01 L 21/3065

21/31

H 01 P 7/06

H 01 Q 13/10